■ 公募情報

| | |
|---|---|
| 公募No. | 2027R-2 |
| 職種 | 有期研究員 |
| 部署 | 未来ICT研究所小金井フロンティア研究センター超高周波ＩＣＴ研究室 |
| 研究テーマ | ミリ波・テラヘルツ波帯デバイス・モジュール性能評価技術の研究開発 |
| 研究テーマ要旨 | ミリ波帯およびテラヘルツ帯で動作する半導体デバイスの性能評価及び送受信モジュールによる無線伝送実験に関係した基盤技術について研究開発を行う。例として以下を挙げるが、採用者の専門と経験に応じて具体的なテーマを決定する。1) 化合物半導体電子デバイスやSi-CMOS等の能動・受動素子、MMIC等の性能評価技術の開発、2) 送受信モジュールによる無線伝送実験技術の開発、3) ミリ波帯・テラヘルツ波帯の高周波回路・導波管部品・アンテナ・モジュール及び構成素材の性能評価技術の開発、4) 化合物半導体電子デバイスやSi-CMOS等の能動・受動素子、送受信モジュール、導波管部品、アンテナ・モジュール等の設計・試作技術の開発。 |
| 自発的な研究活動等の実施に関して | 機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格があります。 |
| 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無 | 【有】 |
| 応募要件 | 理工学分野の博士号（見込みも含む）または同等と認められる者。ネットワークアナライザやスペクトラムアナライザ、リアルタイムオシロスコープなどを用いて、ミリ波帯およびテラヘルツ帯で動作するデバイス（化合物半導体電子デバイス、Si-CMOS、MMICなど）の性能評価及び送受信モジュールによる無線伝送実験に関する知識と経験を有する。研究業務への高い意欲を持ち、関係者と協力して創造的な研究開発が実施できる方。 |
| 募集人員 | 1 人 |
| 本年度契約期間 | 採用日　～　令和10年3月31日（更新の可能性：有り） |
| 更新した場合の雇用期間（又は期日） | 一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年 |
| 給与(本給) | 541,000円　～　558,000円/月<br>本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。 |
| 勤務地名称 | 本部<br>(東京都小金井市) |
| 勤務頻度 | 週5日（週37時間30分勤務）　※時間外労働有 |

※従事する業務及び勤務地の変更の範囲：原則として変更無し
※部署の名称、勤務地の名称、及び研究テーマや研究テーマ要旨内の表現に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

NICT有期雇用職員公募情報：https://www.nict.go.jp/employment/apply.html